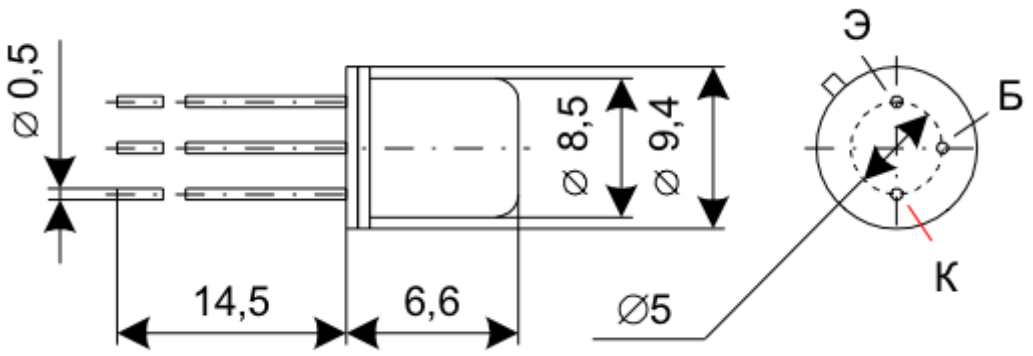
2Т635А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n переключательные.
Предназначены для применения в импульсных и высокочастотных устройствах.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
Тип прибора указывается на корпусе. Тип корпуса: КТ-2-7.
Масса транзистора не более 3 г.
Технические условия: аА0.339.051 ТУ.
Изготовитель - завод «Транзистор», г. Минск.



Основные технические характеристики транзистора 2Т635А:

- h21э - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ: 25…150;
- fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока для схемы с ОЭ: не менее 250 МГц;
- Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 10 пФ;
- Iкэо - Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В: не более 10 мкА;
- Iкэо - Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 0, Uкэ = 60 В: не более 10 мкА;
- Uкб max – Максимальное постоянное напряжение коллектор-база : 60 В;
- Uэбо max - Максимальное напряжение база - эмиттер: 5 В;
- Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 1 А;
- Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,5 Вт.

ООО “РадиоЭлемент”
www.radioelementy.ru
192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 36
(812) 560-06-52, 560-38-24, 702-99-25